

次世代パワー半導体材料のスライシング・ダイシング技術

～ SiC, GaN の切断/割断技術 ～

パワー半導体市場は、5G 関連などの情報通信機器分野や、中国、欧州における自動車・電装分野の需要増加などもあり、大幅に増加している。その中でも大きな伸びを見込まれているのが SiC、GaN、Ga2O3 等の次世代パワー半導体である。本研究会では、次世代パワー半導体材料の切断/割断技術に注目して、次世代パワー半導体切断のエキスパートをお招きし、最新のスライシング、ダイシング技術についてご講演をいただきます。



主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2023 年 4 月 14 日(金) 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

〒100-0004 東京都千代田区区大手町 1-8-1 KDDI 大手町ビル 22F

TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター カンファレンスルーム 22A

電話：03-3243-5231 <https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-otemachi/access/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。

13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～13:55	講演1 「SiC ウエハのレーザスライシング技術」	埼玉大学 山田 洋平 氏
13:55～14:45	講演2 「GaN ウエハのレーザスライシング技術」	名古屋大学 田中 敦之 氏
14:45～15:05	<休 憩>	
15:05～15:55	講演3 「パワー半導体デバイスのレーザダイシング技術」	浜松ホトニクス株式会社 飯田 哲也 氏
15:55～16:45	講演4 「割断を応用した化合物半導体(SiC)の結晶へき開型切断加工」	三星ダイヤモンド工業株式会社 北市 充 氏
16:45～16:55	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会（予定）	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（消費税 10%を含む）

※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（消費税 10%を含む）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2023 年 4 月 6 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附由美宛

・FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>